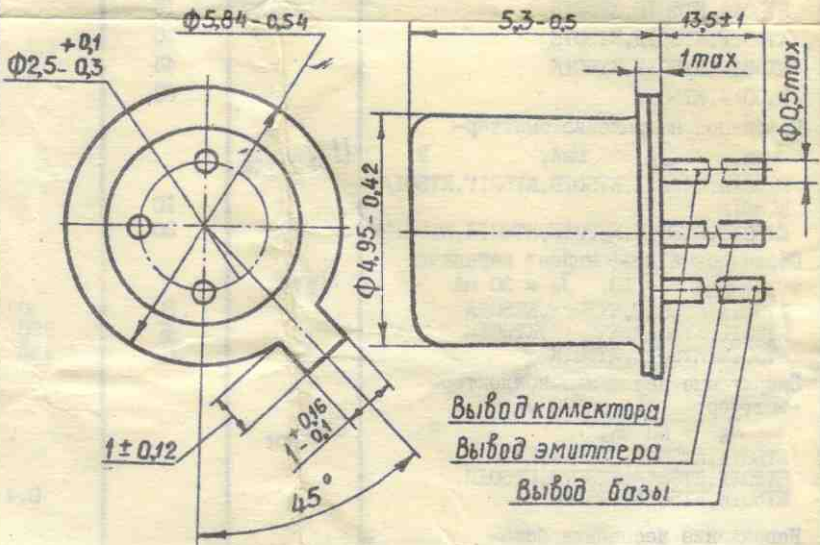


ЭТИКЕТКА



Транзисторы типов: КТ501А, КТ501Б,
 КТ501В, КТ501Г, КТ501Д, КТ501Е,
 КТ501Е, КТ501Ж, КТ501К, КТ501Л, КТ501М
 соответствуют ГОСТ 11630 - 84 и
 техническим условиям АА0.336.064 ТУ



26.08.82

Масса транзистора не более 0,6 г

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт.
 транзисторов :

золото 94,97 192 мг

Л.Н.

**Основные электрические параметры при нормальных
климатических условиях**

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения, тип транзистора	Буквенное обозначение	Н о р м а	
		не менее	не более
Пробивное напряжение коллектор-эмиттер, $R_{БЭ} = 10 \text{ кОм}$, $I_K = 1 \text{ мкА}$, В	$U_{КЭRпроб}$		
KT501A, KT501B, KT501B		15	
KT501Г, KT501Д, KT501E		30	
KT501E, KT501И, KT501К		45	
KT501Л, KT501М		60	
Пробивное напряжение эмиттер-база, $I_B = 1 \text{ мкА}$, В	$U_{ЭБпроб}$		
KT501A, KT501B, KT501B, KT501Г, KT501Д, KT501E		10	
KT501E, KT501И, KT501К, KT501Л, KT501М		20	
Статический коэффициент передачи тока, $U_{КЭ} = -1В$, $I_K = 30 \text{ мА}$	$h_{21э}$		
KT501A, KT501Г, KT501E, KT501Л		20	60
KT501B, KT501Д, KT501И, KT501М		40	120
KT501B, KT501E, KT501К		80	240
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер $I_K = 300 \text{ мА}$, $I_B = 60 \text{ мА}$, В	$U_{КЭнас}$		
KT501A, KT501B, KT501B, KT501Г, KT501Д, KT501E, KT501И, KT501Л, KT501К, KT501Л, KT501М			0,4
Напряжение насыщения база-эмиттер, $I_K = 300 \text{ мА}$, $I_B = 60 \text{ мА}$, В	$U_{БЭнас}$		
KT501A, KT501B, KT501B, KT501Г, KT501Д, KT501E, KT501E, KT501И, KT501К, KT501Л, KT501М			1,5

Место штампа ОТК



Место штампа

Государственной приёмки